JP-A-4-27145 further teaches that the fixation method of the radiation boards can be performed by bonding, caulking, or the like in accordance with the usage thereof.

## SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP4027145

Publication date:

1992-01-30

Inventor(s):

OTSUKI TETSUYA

Applicant(s)::

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

☐ JP4027145

Application Number: JP19900132272 19900522

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/29

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PURPOSE:To improve the effect of heat emitted from a semiconductor chip by installing a plurality of heat radiation boards to a semiconductor device.

CONSTITUTION: A semicoductor chip 2 is directly bonded with the bottom of heat radiation boards. An upper heat radiation board 5a and a lower heat radiation board 5b are connected by means of connection pins 6 arrayed in plural. A projected type connection pin 6b is installed to the bottom of the heat radiation board 5b so as to fix a lead frame 4. After the semiconductor chip 2 and a gold line 3 are connected, the projected pin 6b on the bottom of the heat radiation board 5b is arranged to fit in a recessed pin on the heat dissipation board 5a and fixedly connected with each other. The both upper and lower heat radiation boards 5a and 5b are interfaced with a top force 7a and a bottom force 7b of each mold sealing mold and fixed inside the mold when the mold is clamped. This construction prevents the inclination of the heat radiation boards 5a and 5b induced by resin injection pressure. Moreover, the heat radiation boards 5a and 5b are fixed by means of resin 1 and a connec tion pin 6, which makes it possible to improve bonding performance. Further more, since the heat dissipation boards are designed in multi-structure, it is also possible to enhance the effect of heat radiation.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

It is further disclosed that the fixation method of the radiation boads can be performed by bonding, caulking, or the like.

## 的日本国特許庁(JP

## ① 特許出願公開

平4-27145

# 母公開特許公報(A)

 識別記号 庁内整理番号

**6**公開 平成4年(1992)1月30日

7220-4M H 01 L 23/36

Α

審査請求 未請求 請求項の数 I (全4頁)

**公**発明の名称 半導体装置

**和特 顧 平2-132272** 

❷出 頤 平2(1990)5月22日

杂明者 大槻 哲也是

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

の出 願 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

の代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明 細 1

1. 発明の名称

半導体装置

#### 2.特許請求の範囲

半導体素子の電低とリードフレームのインナー リードとをそれぞれワイヤで接続し、前記半導体 煮子から発生する熱を放出する放熱板と共に樹脂 等で対止してなる半導体装置において、前記放熟 板を装置上下部もしくは内部に複談改有すること を特徴とする半導体装置。

#### 3.発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

半導体装置の構造にかかり、さらに詳しくは放 熱板を有する半導体装置に関する。

#### 【従来の技術】

半導体装置は、半導体チップ2の電気的特性の

引き出しのため、金額 5 Kよりリードフレーム 4 と接続されている。この半導体チップ 2 。金額 5 の保護を目的として、通常樹腐 1 Kで封止されている。また、半導体チップ 2 からの熱を放出するため、各種方法が取られている。

第4回(c)は放熱フィン形パッケージの断面を示した図であるが、第4回(c)では、半導体チップ 2 搭載部(以下ダイパット部と称する)をパッケージ側面部からフィン状に貫出させ放熱性を向上させたものである。放熱フィン1 0 は、リードと同一平面上に出されている。

第4回(4)は放熱板内蔵パッケージ新面を示した図であるが、第4回(4)では、ダイパット部面積を広く取りパッケージ内部に対止することで放無性を向上させる。放無板11は、面積が広くパッケージに内蔵されている。

第4回(c)は放熱板質出形パッケージ新面を 示した回であるが、第4回(c)では、ダイパッ ト部を厚くし、パッケージ表面に異出させ放熱性 を向上させたものである。放熱板12は、リード

. . . •

と乗車方向に出されている。

現在、これらのうち放射性及び製造プロセスの 容易性より第4図(a)が広く用いられている。

#### [発明が解決しようとする課題]

半導体チェブは高集酸化、高出力化の傾向にあり、それに合わせて本来半導体チェブの保護を目的とした対止においても、放熱特性の向上要求が高まってきている。そのため、対止での放熱特性向上を目的とし、各種の方法が考えられている。

第4図( a )は、放熱フィン10を用いて放射性を向上させるものであるが、放熱フィン10がリードと同列に接地されているため、リードレイアクト上のロスが多く、多雄子出力の半導体チャブには不適である。また、放熱フィン10がパッケージを横断しているため、樹脂1と放熱フィン10との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4図(4)では、放薦板11がパッケージに 内蔵されていることで、放薦効果を上げるもので あり第4回(4)に比べ、リードレイアクトへのロスがなく改善されている。しかし、放射板11が放射性の思い樹脂1にて包まれているため高い放射性が見込めない。また、樹脂1と放射仮11との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4回(c)では、放熱板12をパッケージ表面に無断板12に対熱特性をあり、高い放熱特性をあるしかし、放熱板12はリードをあるために装着されているのみであるため、機械30のに力には要かったのは、数板12にの側を中、放熱板12にの側を中、放熱板12にの側を中、放射が12にの間間もあった。また、樹脂1と以外があった。

そこで、本発明はこのような問題点を解決する もので、その目的は高い政制特性及び政制板と樹 用との密着性向上をはかることのできる半導体装 量を提供することにある。

#### [課題を解決するための手段]

本発明の半導体接置は、半導体素子の電価とリードフレームのインナーリードとをそれぞれワイヤで接続し、前記半導体素子から発生する熱を放出する放熱板と共化樹間等で対止してなる半導体接置において、前記放熱板を装置上下部もしくは内部に複数枚有することを特徴とする。

#### [寒放例]

本発明の実施例を説明するに当り、第3回に示したものと、同一もしくは相当部分には同符号を 使用し、説明を省略する。

本発明の実施例を示す。第1回(a)は、半導体装置の断面回であり、半導体チップでは下面放 熱板5 4 に直接顕着されており、上下の放射板 5 a.5 4 は放射板上に複数配列された結合ビン 6 により接合されている。第1回( 4 )は、下面放 熱板5 4 とリードフレーム 4 の固定方法及び半導体チップで、金融 3 のレイアクトを示している。 下面放射板5 4 には、結合ビンとして凸型ビン 6 ♪が*ま*けられており、この凸型ピンゟ♪を使用し

リードフレーム4の固定を行なう。下面は熱板5 1とリードフレーム 4 の固定後、半導体チップ 2 及び金額3の接合を行なり。第1四(c)は、上 面放熱仮5 ェリードフレーム4 下面放熱仮5 4 の固定方法を示したものである。金額なKよる扱 放終了後、下面放射板 5 A の凸ピン 6 A 化上面放 船板5 aの凹ピン b aを合わせ、上下放船板5 a ,5 )を結合固定する。第1回(4)は、対止の 罪の新面図である。上下の放熱板5 € , 5 ♭は、 それぞれ対正会型の上型フェ下型フトに乗し、全 型クランプ時に全型内に固定される。このため、 街路往入の撃の圧力による放熱板 5 4 。 5 4 の様 きがなく安定した品質が確保される。また、放無 仮ちゅっちょは樹頭1との装着力のみではなく。 趙合ピンもにより頭定されているため、密着性に おいても向上される。さらに、放熱板が複数構造 となっているためは熱効果が向上される。

第2回、第3列に、他の実施例を示す。第2回 は上下放射質84、84に加えダイベット部に8 ▶ , 8 d と 8 ♪ の間にさらに放熱質 8 c を設け、 四層構造となっている。また、第 5 回では上下放 熱質 9 c , 9 c の形状を変えダイパット部に放射 変 9 c を設けた三層構造のものである。

したがって、放無板の数、形状については自由 に変化させることが可能であり、放無板の結合図 定方法も用途に応じて、接着、カンメ等可能であ る。また、放無板の素材についても、金属、セラ ミック、構図でも良い。

#### [発明の効果]

以上の説明より、本発明では複数の放無板を使用した半導体装置を提供することにより、半導体チップから発せられる熱を放出する高い放無性を得られるとともに、高信領性、高品質を得ることができる。

## 4.図面の簡単な説明

第1 図( 4 )は、本発明を示す新面図。第1 図 ( 4 )は放熱板とリードフレームの位置関係を示

フォーー対止下型

8 4 -- 放熱板

8 4 - - 放熱板

8 c -- - 放熱板

8 4 -- 放斯板

9 4 -- 放船板

タカーー放熱板

9 c - - 放船板

1 0 - - 放熱フィン

11一一放熱板

12~~放熱板

以上

出票人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 鈴木宮三郎(依1名) した平面図。第1図(c)は、上下放熱板とリードフレームの固定方法を示した新面図。第1図の位置内での会型と放熱板の位置開発した新面図。第2図は、放熱板を三枚使用した実施例新面図。第3図は、放熱板を三枚使用した実施例新面図。第4図(c)は、新面図。第4図(c)は、新田形がボッケージを示す新面図。第4図(c)は、新田形がありません。

1 - - - 樹 殿

2.---半導体チップ

3 --- 金 線

4---リードフレーム

5 4 - - 放熱板

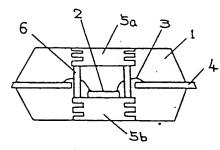
5 カーー放船板

6 --- 結合ピン

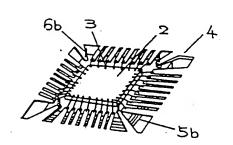
6 4 - - \*\* ピン

6 B - - B E >

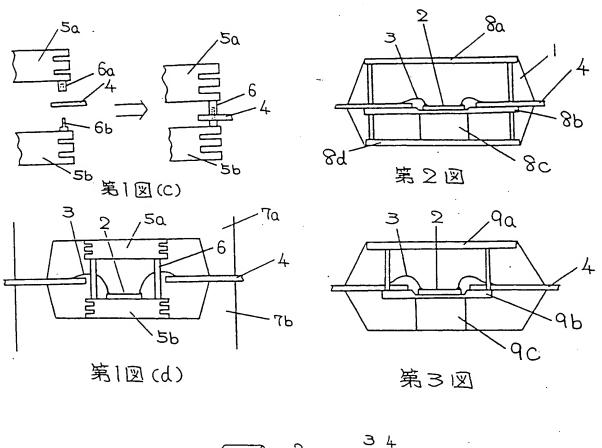
7 4 - - 對止上型

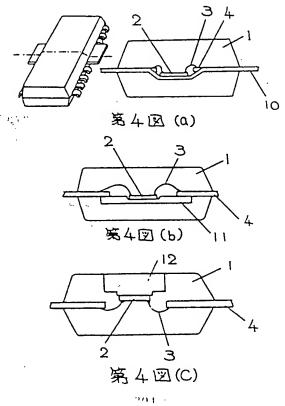


第1図(a)



第1四(b)





THIS PAGE BLANK (USPTO)